BL-3A, BL-4C/2022P007

共鳴 X 線回折実験による GdOs₂Si₂の多彩な磁気秩序状態の解明 Various magnetic ordering of GdOs₂Si₂ studied by resonant x-ray diffraction

林浩章 1,2*, 吉田紘行 3, 山浦一成 1,2

¹物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点,〒305-0044 茨城県つくば市並木1丁目

2北海道大学大学院総合化学院,〒060-0810北海道札幌市北区北10条西8丁目

3北海道大学理学部物理学科,〒060-0810北海道札幌市北区北10条西8丁目

Hiroaki HAYASHI^{1, 2*}, Hiroyuki K. YOSHIDA³, and Kazunari YAMAURA

¹National Institute for Materials Science, Research Center for Materials Nanoarchitectonics,

1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan

²Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University,

Sapporo, Hokkaido 060-0810, Japan

³Department of Physics, Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido 060-0810, Japan

1 <u>はじめに</u>

物質中のスキルミオン格子は、2009年に MnSi に おいてはじめて確認された[1]。その起源は結晶構造 の空間反転対称性の破れに起因した、DM 相互作用 だと考えられている。一方、最近では空間反転対称 性が保たれた系におけるスキルミオン格子の形成に 大きな注目が集まっている。例えば、正方晶 ThCr₂Si₂型構造(空間群: *I4/mmm*)に分類される GdRu₂Si₂は[2]、反転対称性を有するスキルミオン物 質として報告されており[3,4]、その起源を説明する 新しい理論も提案されている[5]。

我々は、このような反転対称性を有するスキルミ オン物質の開発を目的として物質探索を行い、 GdRu₂Si₂の類似物質である GdOs₂Si₂の単結晶育成に 初めて成功した。本物質は GdRu₂Si₂ と同様の ThCr₂Si₂型構造をとり[6]、磁化・比熱・電気伝導特 性から多彩な温度・磁場相図が示されている。また、 一部の相でホール抵抗の異常が確認され、局在・遍 歴電子の協奏による複雑な磁気構造が予測されてい る。本研究では、これらの磁気秩序相の微視的機構 を調べるため、KEK Photon Factory (PF)の BL-3A, 4C において共鳴 X 線散乱実験を行った。



強度因子	: f =	(\mathbf{k}_{i})	\times	$k_{\rm f}$	•	2
------	-------	--------------------	----------	-------------	---	---

(4, 2, 0) 方向		(4,0,0)方向		
π-π'偏光	$S_{[001]}$	π-π'偏光	$S_{[001]}$	
π-σ'偏光	$S_{[100]}$	π-σ'偏光	$S_{[110]}$	

図1:試料セッティングの様子。

2 実験

測定は PF BL-3A および BL-4C にて、E=7.932 keVの硬 X 線と、シリコンドリフト検出器を用いて行った。GdOs₂Si₂単結晶試料($1.08 \times 0.50 \times 0.22 \text{ mm}^3$)は、結晶の[100]方向が散乱面と平行になるように GE ワニスで固定し(図 2)、逆格子点(4, 2, 0)と(4, 0, 0) 周りの磁気反射を探索した。測定温度・磁場範囲は、それぞれ 2 K – 35 K, 0 T – 4 T である。

3 結果および考察

温度・磁場相図における Phase I – III の各相につい て、逆格子点 (4,0,0) 周りの磁気反射の探索を行っ たところ、Gd L_2 端 ($2p \rightarrow 4f$ 遷移: E = 7.932 keV) での共鳴散乱による超格子反射が、(4- δ ,0,0)の位置 に確認された(図 2)。各相における δ を詳しく見 ていくと、Phase I では $\delta = 0.28$ に1つ、Phase II では $\delta = 0.19, 0.26, 0.31$ に3つの超格子反射が確認された。 また、両相の相境界付近では、これら4つの反射が すべて観測されることから、磁場に対して一次転移 を示し、両相が混在している状態が示唆される。



図 2: GdOs₂Si₂の温度・磁場相図(左)と、各相に おける(4-*δ*, 0, 0)逆格子スキャンの結果(右)。

Phase II'では、Phase I で見られた δ = 0.28 の反射が 復活した。一方で、反射の強度は Phase I と比べて 10 分の 1 程度に小さくなっている。Phase III では δ = 0.31 に 1 つの反射が確認された。

次に、Phase II における磁気秩序状態を明らかにす るため、 $\delta = 0.19, 0.26, 0.31$ の 3 点で見られた反射の 重ね合わせた点 (4- δ , - δ , 0)の探索を行った。結果は 図 3 に示すように、 $\delta \sim 0.19, 0.31$ で double-Q 状態を 示唆する磁気反射が確認された。Phase II では、我々 の実験によって異常ホール効果を観測しており、 GdRu₂Si₂ との比較からも、スキルミオンなどのトポ ロジカルに非自明な磁気構造が発現していると考え られる。一方で、 $\delta = 0.26$ の重ね合わせた点では、反 射は確認されなかった。

最後に、H=0T (Phase I) における (4- δ , 0, 0) 逆格 子スキャンで観測された超格子反射の温度依存性を 図4に示す。2Kから10Kにおいて、反射は δ =0.28 の位置に観測された。一方で10K以上では、温度の 上昇に伴って反射が見られる δ の値は増加し、転移 温度($T_N = 26.6$ K) 近傍では δ =0.29 となる。これ は、温度上昇によって短い周期構造へと伝搬ベクト ルが変調していることを表している。このような磁 気構造の僅かな変化は、磁化測定では観測されてお らず、本測定で明らかとなった GdOs₂Si₂の新たな一 面である。



図 3: Phase II において、(4-*δ*, -*δ*, 0) で確認された超 格子反射(*δ*~0.19, 0.31)。



 $図 4: H=0T における、 \delta の 温度依存性。$

4 <u>まとめ</u>

本研究では、GdOs₂Si₂の多彩な磁気秩序相を明ら かにするため、単結晶試料を用いた共鳴 X 線回折実 験を行った。Phase I では、(4- δ , 0, 0) で確認された δ = 0.28 の伝搬ベクトルが、温度依存性を示すことが わかった。また、Phase II における (4- δ , - δ , 0) の超格 子反射 (δ ~0.19,0.31) は、スキルミオンをはじめと した Multi-Q 状態の発現を示唆している。

今回の実験では、GdOs₂Si₂の各相における詳細な 磁気構造の解明には至らなかったが、追加測定や偏 光解析など、次回につながる充実した内容となった。 今後も GdOs₂Si₂の磁気秩序相の微視的機構を明らか にするため、磁化・比熱・電気伝導特性と照らし合 わせながら共鳴 X 線回折実験を行い、考察を深める。

謝辞

本研究にあたり、BL-3A, 4C のビームライン担当者 である中尾裕則氏には、実験原理から測定に至るまで 丁寧にご指導いただきました。本実験は申請者にとっ て初めての PF 実験でしたが、充実した内容となりま した。ありがとうございました。また本研究は、日本 学術振興会科学研究費(JP22H04601)および公益財 団法人大倉和親記念財団(2022-11)の助成を受けて 行われました。

参考文献

- [1] A. Neubauer et al., Phys. Rev. Lett. 102, 186602 (2009).
- [2] K. Hiebl et al., J. Magn. Magn. Mater. 37, 287-296 (1983).
- [3] N. D. Khanh et al., Nat. Nanotech. 15, 444 449 (2020).
- [4] Y. Yasui et al., Nat. Commun. 11, 5923 (2020).
- [5] M. Hirschberger et al., New J. Phys. 23, 023039 (2021).
- [6] H. Hayashi et al., JPS Conf. Proc. 38, 011103 (2023).

成果

 <u>H. Hayashi</u>, H. K. Yoshida, K. Yamaura, "Topological Hall effect and skyrmions in GdOs₂Si₂", Oral presentation, The 32nd Annual Meeting of MRS-J, Yokohama, Japan (2022).

* HAYASHI.Hiroaki@nims.go.jp